

【書類名】

【図 1】

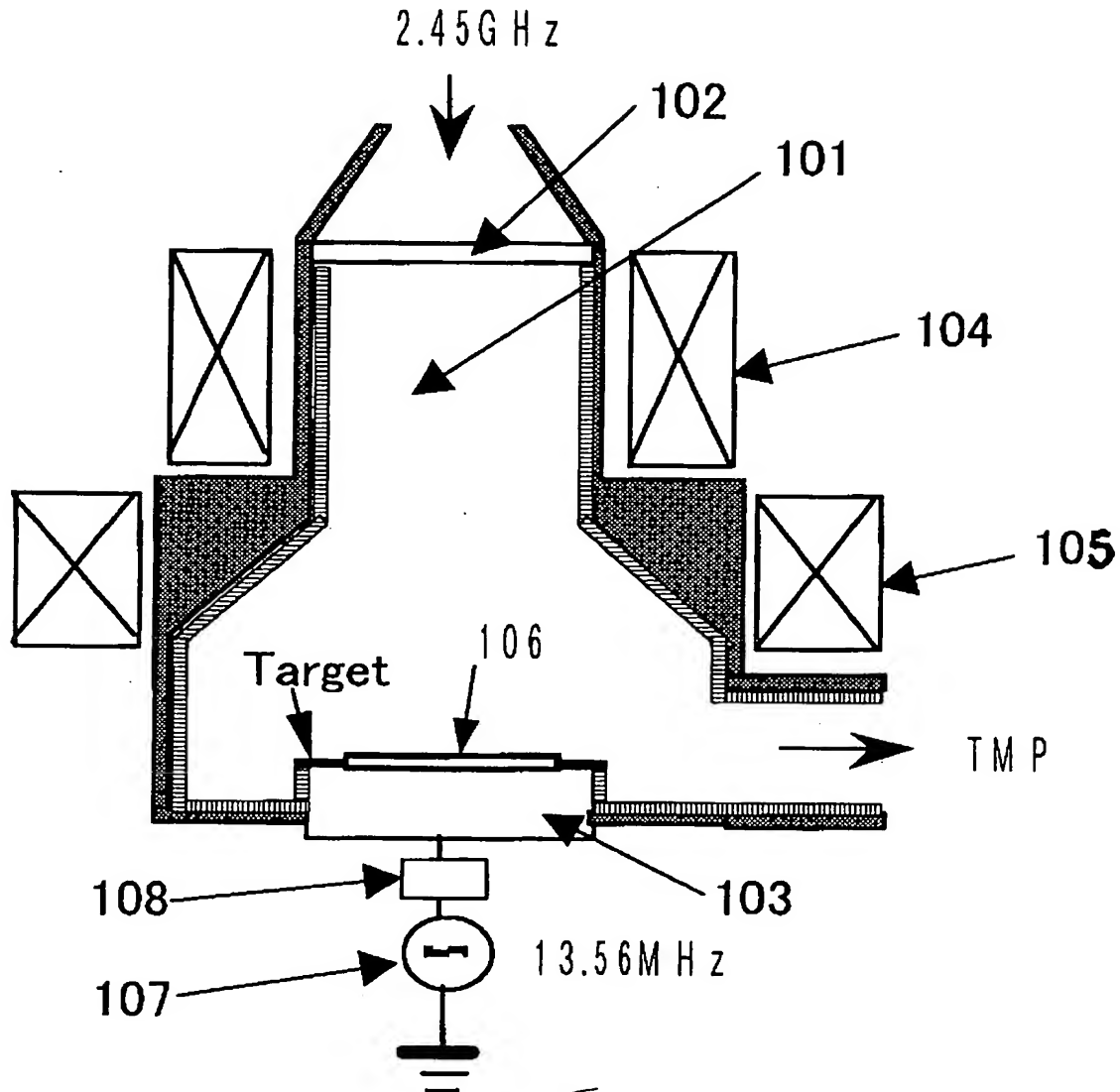


Fig. 1

整理番号 = P -

4 年 1 0 月 9 日  
頁: 2 / 7

【図 2】

Fig. 2(a)

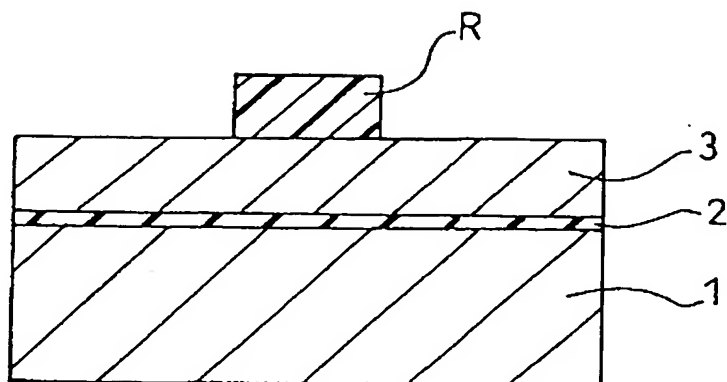


Fig. 2(b)

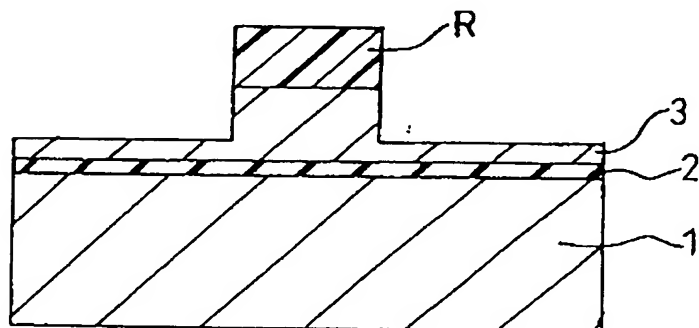
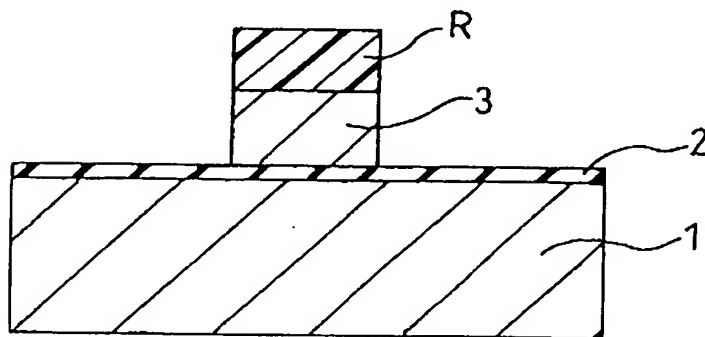


Fig. 2(c)



【図3】

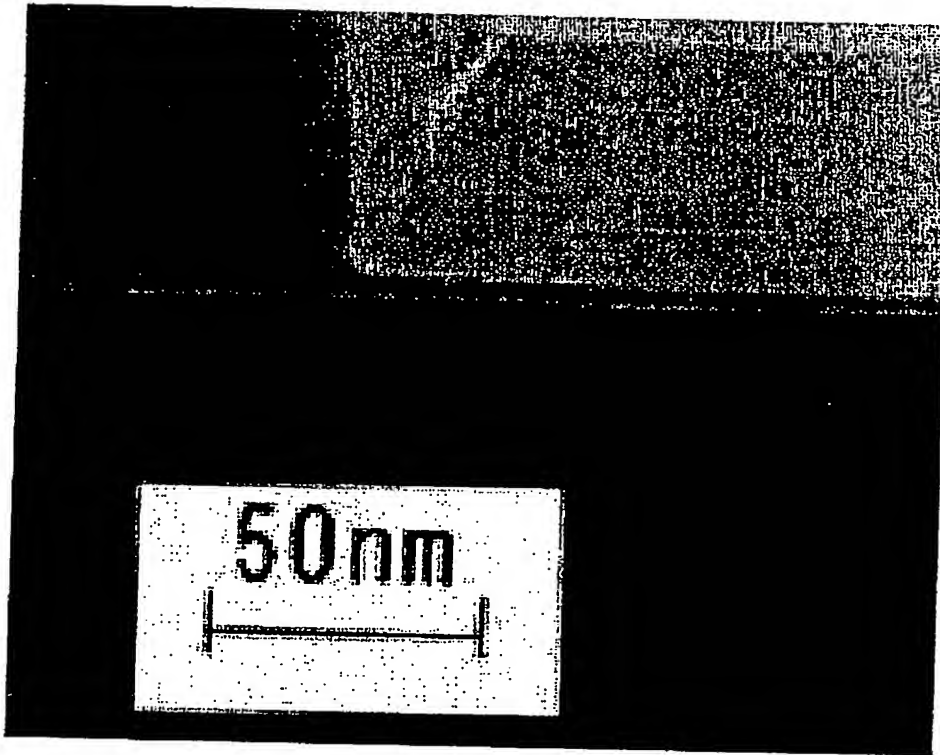


Fig-3

【図4】

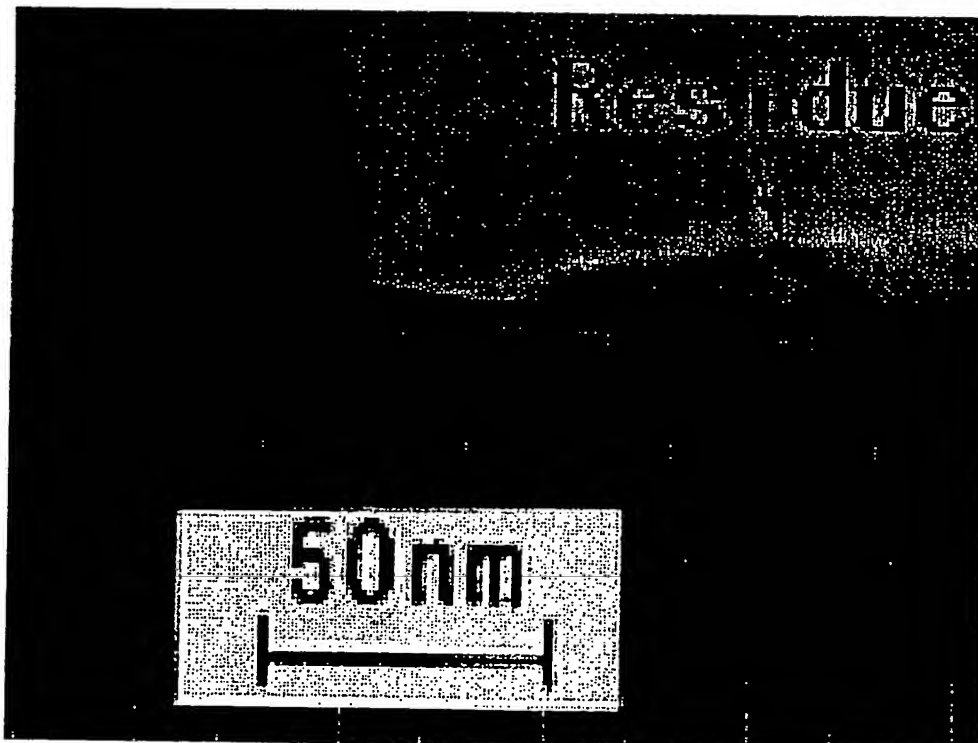


Fig-4

整理番号 = P - 4

年 10 月 9 日  
頁: 4 / 7

【図 5】

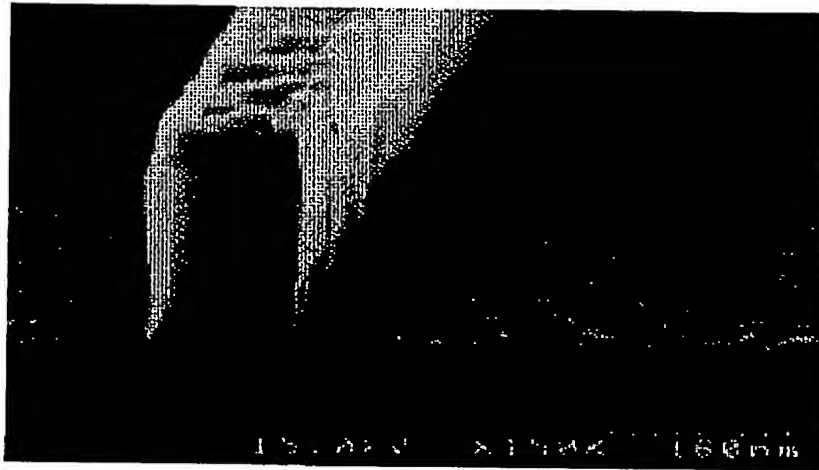


Fig. 5

【図 6】

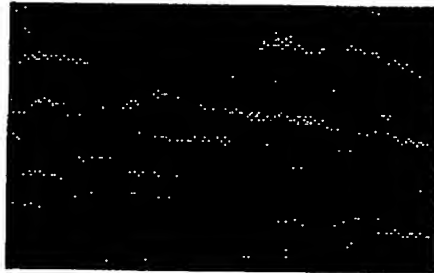


Fig 6 (a) partially etched polySi



Fig 6 (b) gate oxide surface  
Surface morphology of polySi and gate oxide.

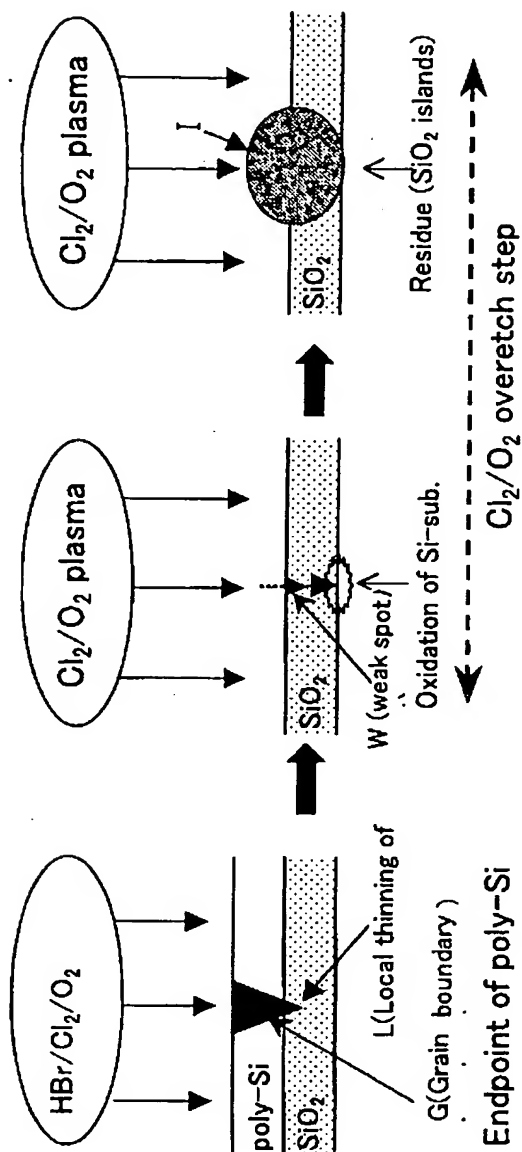


Fig. 7

整理番号 = P - 4

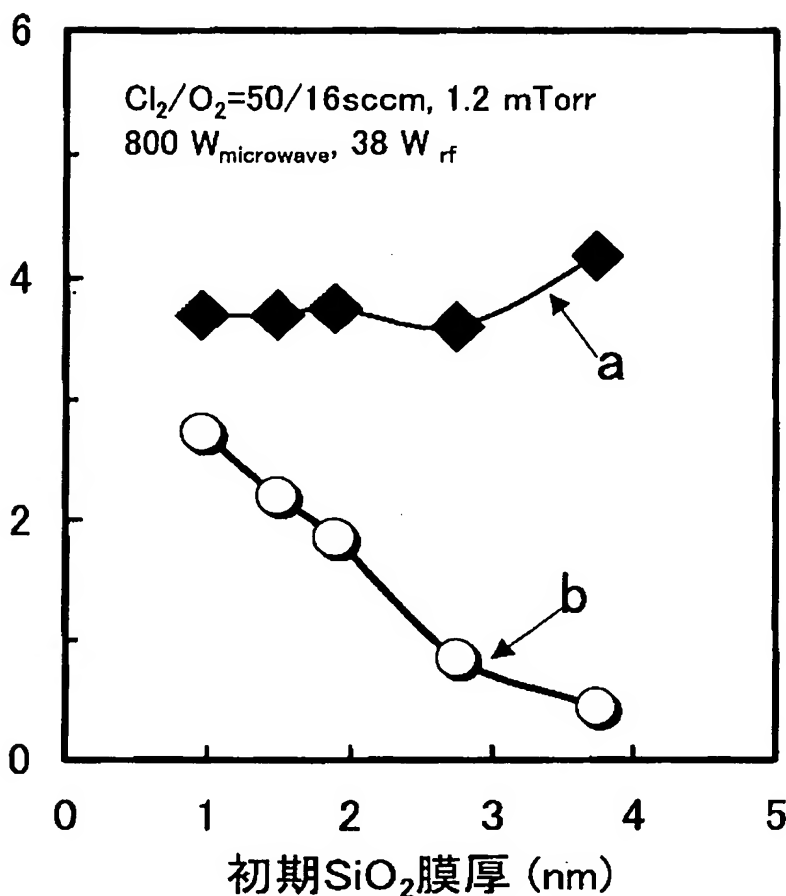
年 10 月 9 日  
頁: 6 / 7

【図 8】

Fig. 8

SiO<sub>2</sub> 膜厚増大量,  
SiO<sub>2</sub> 最終膜厚 (nm)

Increase of Thickness  
And  
Final Thickness



初期SiO<sub>2</sub>膜厚 (nm)

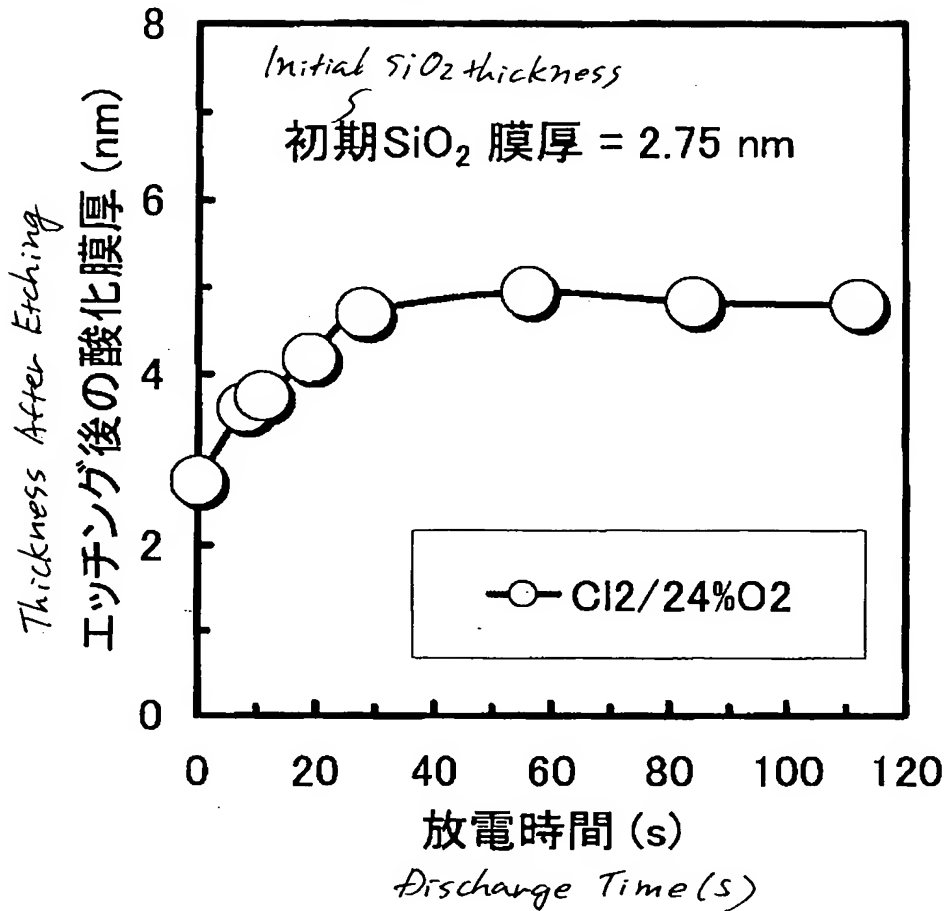
Initial Thickness (nm)

整理番号 = P -

4年10月 9日  
頁: 7/ 7

【図9】

Fig. 9



【図10】

Fig. 10

